

**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**(11)Publication number : **09-092881**(43)Date of publication of application : **04.04.1997**

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

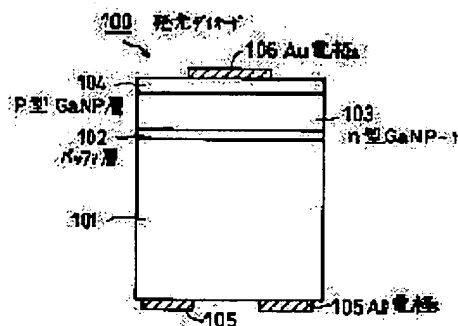
H01S 3/18

(21)Application number : **07-242245**(71)Applicant : **TOSHIBA CORP**(22)Date of filing : **21.09.1995**(72)Inventor : **FUJIMOTO HIDETOSHI  
NISHIO JOSHI****(54) COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVICE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nitride compound semiconductor device having high reliability.

SOLUTION: Conductive aluminum oxide is used as a growth substrate 101 of a nitride compound semiconductor device 100. To provide the substrate 101 with conductivity, impurities are introduced into the substrate 101, for example. Due to the conductivity of the substrate 101, there is no need to conduct etching or the like to establish electric contact with internal layers which do not appear on the surface of a layered structure. As a result, a device can be formed without damage caused by processing an epitaxial layer.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-92881

(43)公開日 平成9年(1997)4月4日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 33/00			H 0 1 L 33/00	C
H 0 1 S 3/18			H 0 1 S 3/18	

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平7-242245

(22)出願日 平成7年(1995)9月21日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 藤本 英俊

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 西尾 謙司

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

(74)代理人 弁理士 外川 英明

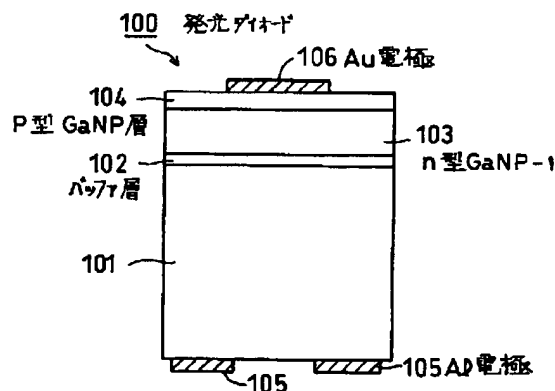
(54)【発明の名称】 化合物半導体装置

(57)【要約】

【目的】本発明は信頼性の高い窒化物化合物半導体装置を提供することを目的とする。

【構成】窒化物化合物半導体装置(100)の成長用基板(101)として導電性を有するアルミニウム酸化物を用いる。この基板に導電性を持たせるための一つの方法として不純物を添加する。

【効果】基板に導電性があるため、積層構造における表面に現われていない内部層への電氣的接触を取るためのエッチング処理などを必要としない。そのため、エピタキシャル層を加工することによる損傷を与えることなく、素子を形成することができる。





水圧のホットプレスした。この焼結体を $300\mu\text{m}$ 厚にスライスして基板101とした。炭素の量としては透過率などの光学特性から20%以下が望ましい。

【0008】発光ダイオード100は導電性アルミナ基板101の上に周知の有機金属気相成長法(MOCVD法)などによって、厚さ200オングストローム(以下Aと記述する)のAlNからなるバッファ層102、厚さ $3\mu\text{m}$ のn型GaN層103、厚さ $1\mu\text{m}$ のp型GaN層104がこの順で積層したものである。アルミナ基板101は炭素を展開することにより導電性を有していることから、エッチング処理をすることなしに発光ダイオードチップ100を形成することができる。電極としては基板側にAl電極105、p型GaN層側にAu電極106を形成している。このような素子においては、導電性のない従来のサファイア基板を用いた場合と比較して、輝度に変化は見られないが、信頼性に約1桁の改善が見られた。

【0009】尚、本実施例においては炭素添加アルミナ基板101に直接AlNバッファ層102を設けたが、基板101として炭素添加アルミナ上にシリコンカーバイドを形成したものを用い、その上にAlNバッファ層を形成すれば、基板とバッファ層の密着性が高まり、さらに信頼性が向上する。

【0010】(実施例2)図2に本発明の実施例に関わる発光ダイオード200の構造断面図を示す。発光ダイオード200では、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 単結晶に導電性を持たせるための不純物としてSiを1%程度添加したもの201を成長用基板として用いている。

【0011】導電性 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 単結晶201の製法としては、チョクラルスキー法によって製造される。例えば、純度5Nのアルミナ粉末と純度9NのSiチャンク(重量比10%)とをイリジウムのつぼに入れRF加熱(高周波誘導加熱)によってアルミナの融点である $2040^\circ\text{C}$ 以上に昇温し融液を作る。この融液に(0001)面のサファイア単結晶を種結晶として、速度 $2\text{mm/h}$ で引き上げる。この時の雰囲気は窒素( $\text{N}_2$ )に2%程度の酸素( $\text{O}_2$ )を加えたものが望ましい。この程度の添加量では、母材である $\text{Al}_2\text{O}_3$ 単結晶の品質を損ねることなく導電性を確保することは可能であった。そのため、不純物の量としては0.1%以上かつ15%以下であることが望ましい。

【0012】この $\text{Al}_2\text{O}_3$ 単結晶基板201の一主面上201aに厚さ600ÅのAlN層202、厚さ $4\mu\text{m}$ のn型GaN層203、厚さ $1\mu\text{m}$ のp型GaN層204がこの順で積層されている。p型GaN層204は発光層としても働く。結晶成長後、オーミック電極として $\text{Al}_2\text{O}_3$ 導電性単結晶基板201およびp型GaN層204に対してそれぞれAl膜205およびIn膜206をおのおの $1\mu\text{m}$ の厚さで形成した。

【0013】以下に、上記発光ダイオード200の製造

方法を順に説明する。この発光ダイオード200は、MOCVD法によって製造された。キャリアガスとして水素( $\text{H}_2$ )を、原料ガスとしてトリメチルガリウム( $(\text{CH}_3)_3\text{Ga}$ ) (以下、TMGと記す)、トリメチルアルミニウム( $(\text{CH}_3)_3\text{Al}$ ) (以下、TMAと記す)、アンモニア( $\text{NH}_3$ )、シラン( $\text{SiH}_4$ )、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム( $(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{Mg}$ ) (以下、 $\text{Cp}_2\text{Mg}$ と記す)を用いた。

【0014】まず、有機洗浄および酸洗浄によって表面を洗浄した $\text{Al}_2\text{O}_3$ 導電性単結晶基板201をMOCVD装置の反応室に載置させた加熱可能なサセプタ上に装着する。

【0015】次に、常圧で $\text{H}_2$ を $20\text{L/分}$ 流しながら、 $1100^\circ\text{C}$ で約10分間、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 導電性単結晶基板201の一主面201aを気相エッチングした。次に、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 基板201を $600^\circ\text{C}$ まで降温、保温し、 $\text{H}_2$ を $10\text{L/分}$ 、 $\text{NH}_3$ を $5\text{L/分}$ 、TMAを $25\text{cc/分}$ の量でそれぞれ流すことにより、AlN層202を約5分形成した。

【0016】次に、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 基板201を $1050^\circ\text{C}$ まで昇温・保温し、 $\text{H}_2$ を $10\text{L/分}$ 、 $\text{NH}_3$ を $5\text{L/分}$ 、TMGを $25\text{cc/分}$ 、 $\text{SiH}_4$ を $10\text{cc/分}$ それぞれ流すことによりn型GaN層203を約1時間形成した。

【0017】次に、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 基板201を $1050^\circ\text{C}$ で保温したまま、 $\text{H}_2$ を $10\text{L/分}$ 、 $\text{NH}_3$ を $5\text{L/分}$ 、TMGを $25\text{cc/分}$ 、 $\text{SiH}_4$ を $1\text{cc/分}$ 、 $\text{Cp}_2\text{Mg}$ を $100\text{cc/分}$ それぞれ流すことによりp型GaN層204を約15分形成した。

【0018】 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 基板201を室温まで降温した後MOCVD装置から取り出し、周知の真空蒸着法を用いて、Al膜205およびIn膜206をおのおの $1\mu\text{m}$ の厚さで形成した。かかる後、窒素雰囲気中、 $300^\circ\text{C}$ の熱処理を施し、オーミック電極とした。

【0019】かかる発光ダイオード20における各層のキャリア濃度は、n型GaN層202が $3\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$ 、p型GaN層203が $2\times 10^{17}\text{cm}^{-3}$ である。このようにして形成された発光ダイオード200を $350\mu\text{m}$ 角の大きさに切り分け、ステム上にマウント、モールドし、ランプが完成する。このようにして形成された発光ダイオードは、従来のサファイア基板を用いた場合の同様の構造の発光ダイオードと比較して、通電劣化が起こりにくく、寿命を約1桁改善することができた。

【0020】本実施例の場合も単結晶基板上にバッファ層102を形成する前に、MOCVD法等によりSiC或いはSiGe層を形成すれば、より信頼性の高い発光ダイオードを得ることができる。

【0021】(実施例3)図3に本発明の第3の実施例に関わる発光ダイオード300の構造断面図を示す。発光ダイオード300はAlとOとからなる導電性の単結

晶301が成長用基板として用いられている。この単結晶基板301は、導電性を持たせるための不純物として銅を2%程度添加している。この単結晶基板301上に厚さ500ÅのGa<sub>0.9</sub>N層302、厚さ4μmのn型Ga<sub>0.9</sub>N層303、厚さ1000ÅのInGa<sub>0.9</sub>N層304、厚さ5000Åのp型Ga<sub>0.9</sub>N層305がこの順で形成されている。成長には周知のMOCVD法でもMBE法でも可能である。電極としては、単結晶基板301に対してAl膜306を、p型Ga<sub>0.9</sub>N層305に対してIn<sub>0.9</sub>Zn膜307を周知の真空蒸着法等で形成し、膜形成後、熱処理などをほどこすことにより、電極金属膜/単結晶(基板あるいはエピタキシャル層)間の結合を起こさせ、良好なオーミック電極とした。本実施例における発光ダイオードでは、発光層に用いられるInGa<sub>0.9</sub>N層中のInの組織比によって、その発光波長を変えることができる、Inの量が0.3以下の範囲で用いられることが、結晶性あるいはIn濃度の制御性の点からはすぐれている。また、基板への不純物としては、さらにイットリウムを加えることが望ましい。このことにより光学的な透過率が増し、外部量子効率の上昇を見込むことができる。原子比で10~20%添加することが望ましく、この時に光学的な透過率は添加しないときと比較して大きな値をとる。

【0022】(実施例4) 図4に本発明の第4の実施例であるレーザダイオード400の構造断面図を示す。レーザダイオード400では、AlとOとからなる導電性の単結晶を基板として用いている。この単結晶基板401は、導電性を有するための不純物としてCが0.5%程度添加されている。この基板401上に厚さ500ÅのAlN層402、厚さ3μmのn型Ga<sub>0.9</sub>N層403、厚さ1μmのn型AlGa<sub>0.9</sub>N層404、厚さ1000ÅのアンドープGa<sub>0.9</sub>N層405、厚さ1μmのp型AlGa<sub>0.9</sub>N層406、厚さ1μmのp型Ga<sub>0.9</sub>N層407がこの順で形成されている。キャリア濃度は順に、n型Ga<sub>0.9</sub>N層403が $3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、n型AlGa<sub>0.9</sub>N層404が $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、アンドープGa<sub>0.9</sub>N層405が $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 、p型AlGa<sub>0.9</sub>N層406が $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、p型Ga<sub>0.9</sub>N層407が $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ である。また、AlGa<sub>0.9</sub>N層404および406におけるAl組成比は0.3である。このレーザダイオード400では従来のサファイア基板を用いた場合と異なり、エッチングなどによってn型Ga<sub>0.9</sub>N層への電気的接触をはかる必要がないため、エピタキシャル成長層402~407に損傷を与えることがない。そのため、信頼性が従来のレーザダイオードに比べて、約1桁の改善を見ることができた。

【0023】(実施例5) 図5に本発明の第5の実施例であるレーザダイオード500の構造断面図を示す。レーザダイオード500では、AlとOとからなる導電性結晶501を基板として用いており、導電性を持たせる

ための不純物としてSiが0.2%程度含まれている。この基板501上にAlN層502(厚さ300Å)、n型Ga<sub>0.9</sub>N層503(厚さ2μm、キャリア濃度 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ )、n型AlGa<sub>0.9</sub>N層504(厚さ2000Å、Al組成比0.3、キャリア濃度 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ )、n型AlGa<sub>0.9</sub>N層505(厚さ2000Å、Al組成比0.15、キャリア濃度 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ )、アンドープGa<sub>0.9</sub>N層506(厚さ300Å)とアンドープInGa<sub>0.9</sub>N層507(厚さ200Å、In組成比0.1)とによる3重量子井戸構造、p型AlGa<sub>0.9</sub>N層508(厚さ2000Å、Al組成比0.15、キャリア濃度 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ )、p型AlGa<sub>0.9</sub>N層509(厚さ2000Å、Al組成比0.3、キャリア濃度 $3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ )、p型Ga<sub>0.9</sub>N層510(厚さ5000Å、 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ )が、周知のMOCVD法またはMBE法(分子線エピタキシー法)によって形成されている。このような素子においては波長400nm、しきい電流値 $3 \text{ kA/cm}^2$ で室温連続発振が生じた。

【0024】(実施例6) 図6に本発明の第6の実施例に関わる発光ダイオード600の構造断面図を示す。発光ダイオード600では、アルイナ(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を主成分とし、これに不純物としてTiCを適量添加した多結晶601を基板とした。基板の製法は実施例1に記載した方法と同様である。TiCの添加量は抵抗値の傾向より、原料粉末の混合時の重量比で30%以上であることが望ましい。これより少ない場合には比抵抗が $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ と高抵抗を示す。40%以上80%以下である時がより望ましい。

【0025】導電性アルミナ基板601上には、基板とエピタキシャル成長層との格子不整合を緩和するためのGa<sub>0.9</sub>Nバッファ層602(厚さ0.1μm)、n型Ga<sub>0.9</sub>N電子電流注入層603(厚さ4μm、Siドープ、キャリア濃度 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ )、n型InGa<sub>0.9</sub>N発光層604(In組成比0.06、厚さ0.1μm、Si、Znドープ)、p型AlGa<sub>0.9</sub>N正孔電流注入層605(Al組成比0.15、厚さ0.5μm、Mgドープ、キャリア濃度 $3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ )、p型Ga<sub>0.9</sub>Nコンタクト層605(Mgドープ、厚さ0.3μm、キャリア濃度 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ )がこの順で積層されている。また、オーミック電極としては、基板601側に厚さ2μmのAu電極607を、またp型Ga<sub>0.9</sub>N層606側にはNi:2000Å、Au:2μmの積層構造608を用いた。

【0026】上述した実施例では基板として半導体を用いることのできる青色の発光ダイオード(紫外も含む)、青色半導体レーザ(同様紫外も含む)について説明したが、例えば青色発光ダイオードが上述の如く上下より電極を取り出すことが可能であれば、簡単に多色の発光ダイオード引いてはディスプレイを得ることができる。具体的に説明すると、導電性のアルミナ基板上にA

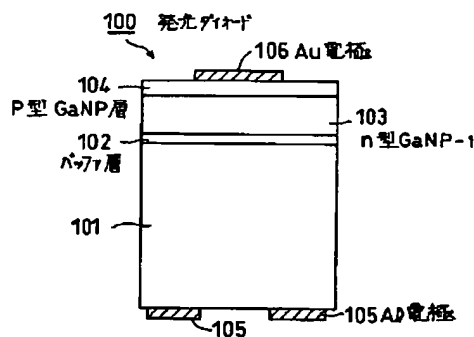
INバッファ層を形成し、その上にInGaP層を形成し、そのInGaP層の一部にAl、他の一部にPをドーピングし、個々に分離すれば、Alドーピングの所は青、Pドーピングの所は赤、何もドーピングしない所は緑の発光が可能となる。このように、赤、緑、青の発光が可能になれば、発光ダイオードでフルカラーの多色ディスプレイができるようになる。そして本発明の場合、基板が導電性を示すものである為、上述の如く上下より電極を取り出すことが可能となり、多色ディスプレイにするための配線も液晶ディスプレイと同じようにできる。したがって自発光の発光ダイオードで液晶ディスプレイのような種々の表示が可能となり、視野角の大きい表示装置を得ることができる。

【0027】また多色の発光ダイオードを得る場合、必ずしも隣接して赤、緑、青を発光する必要なく、材料を工夫して縦方向に積層しても良い。この場合、導電性のアルミナ基板上にバッファ層を設け、その上にp-n接合をなすInGaNP層、p-n接合をなすInGaN層、p-n接合をなすInAlGaN層を順次形成し、基板側から赤、緑、青を発光させるようにするか、不純物のドーピングで多色を発光させるようにしても良い。

【0028】上記実施例では発光素子について説明したが、高耐压のパワーデバイスなどの電子デバイスへの実現も可能である。また、本発明の本旨である導電性のアルミニウム酸化物を逸脱しない限り、導電性を持つための主たる不純物以外にも不純物元素を添加することは可能である。

【0029】

【図1】



(5)

【発明の効果】以上、述べてきたように窒化物化合物半導体の結晶成長用基板として、導電性基板を用いることにより、積層構造表面に現われていない内部層への電氣的接触を取るためのエッチング処理などを必要としない。そのため、積層構造素子に対して損傷を与えることなく加工することが可能であるため、素子の諸特性も向上し、また信頼性の向上を図ることができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例である発光ダイオードの構造断面図

【図2】 本発明の第2の実施例である発光ダイオードの構造断面図

【図3】 本発明の第3の実施例である発光ダイオードの構造断面図

【図4】 本発明の第4の実施例であるレーザダイオードの構造断面図

【図5】 本発明の第5の実施例であるレーザダイオードの構造断面図

【図6】 本発明の第6の実施例であるレーザダイオードの構造断面図

【符号の説明】

100…発光ダイオード

101…導電性アルミナ基板

102…バッファ層

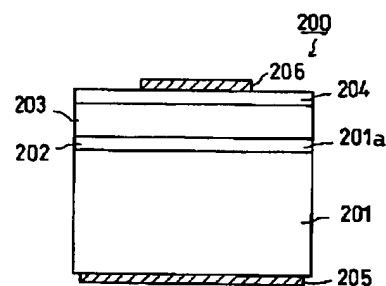
103…n型GaN層

104…P型GaN層

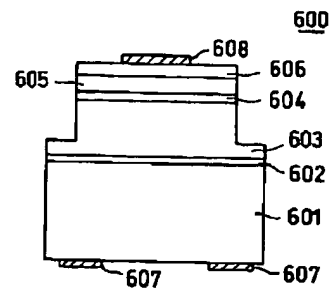
105…Al電極

106…Au電極

【図2】



【図 6】



500

電極

SiO<sub>2</sub>

510

509

508

(GaN) 506

507 (InGaN)

504

505

503

502

501

電極